

Nom: **BOUHOUCHE.**

Prénom : **MANEL.**

Institution :Institut des Sciences et Des Techniques Appliqués

E-mail : bouhouchemanel@gmail.com

FORMATIONS

- Ingénieur d'état en Electronique,option Instrumentation,juin 2001, Université de Constantine.
- Magister en Electronique, option Dispositifs de l'électronique intégrée, juin 2006, Université de Constantine.
- Doctorat es science en Electronique option Dispositifs de l'électronique intégrée, décembre 2012, Université de Constantine.

EXPERIENCES PROFESIONNELLES

Intitulé du module enseigné	Nature Cour/TD/TP	Cycle	Année universitaire
Physique 1	TD	1 ^{ère} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2013 / 2014
Maîtrise d'outils et de logiciels de simulation	Cour et TP	Master 1 : Electrotechnique	2013 / 2014 2014 / 2015
Electronique Fondamentale 1	Cours TD et TP	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2013 / 2014 2014 / 2015
Mesure électrique et électronique	Cour et TP	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2014 / 2015
Technologie de fabrication des circuits intégrés	Cours découverte	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2014 / 2015
Etat de l'art du génie électrique	Cours découverte	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2014 / 2015
Electricité	TP	1 ^{ère} Année Licence : Mesures physiques	2015 / 2018
Système électronique	Cours, TD et TP	1 ^{ère} Année Licence : Mesures physiques	2015 / 2018
Electronique d'instrumentation I	Cours, TD et TP	2 ^{ème} Année Licence : Mesures physiques	2016/ 2018
Technique nucléaire	Cours, TD et TP	3 ^{ème} Année Licence : Mesures physiques	2017 / 2018

Publications

- 1- Christian Gontrand, **Manel Bouhouche**, JoséCruzNuñez Perez, Olivier Valorge, Francis Calmon, Jacques Verdierand SaïdaLatreche, “Mixed-mode analysis of the sensitivity of a radiofrequency oscillator disturbed by parasitic signals”, [Wiley International Journal of Numerical Modelling: electronic networks and fields](#), Vol. 22 Issue 1, January 2009, pp. 23-42 www.interscience.wiley.com
- 2- José-Cruz Nunez-Perez, Maya Lakhdara, **Manel Bouhouche**, Jacques Verdier, Saida Latreche and Christian Gontrand, “First- and second-order electrical modelling and experiment on very high speed SiGeC heterojunction bipolar transistors”, International journalof Semiconductor Science and Technology; Semicond. Sci. Technol. Vol.24, Issue 4, 6 March 2009. <http://iopscience.iop.org/0268-1242/24/4/045010>
- 3- S. Latreche, M. LAKHDARA, **M. Bouhouche**, C. Gontrand, "Low temperature effect on electrical characteristics of SiGe, SiGeC HBT", Journal of optoelectronics and advanced materials – symposia, Vol. 1, N°.3, pp. 242 –245,2009 .
- 4- **M. Bouhouche**, S. Latreche, C. Gontrand, 'Low Frequency Noise in SiGe Bipolar Transistor: Effect of Extrinsic Base Implantation Traps', International Journal of Computer Applications, Vol. 33, No. 6, November 2011, pp.59-64, DOI. 10.5120/4147-5874, <http://www.ijcaonline.org/archives/volume33/number6/4147-5874>.
- 5- **M. Bouhouche**, S. Latreche, C. Gontrand, “Phase Noise Modeling in LC Oscillators Implemented in SiGe Technology”, Journal of semiconductors, Vol. 34, Issue 2, février 2013, DOI: 10.1088/1674-4926/34/2/025001, <http://iopscience.iop.org/1674-4926/34/2/025001>

Communications

- 1-**M. Bouhouche**, S. Latreche, M. Lakhdara, C. Gontrand, “**Influence de la position spatiale des défauts ponctuels sur les caractéristiques électriques d’un TBH**” ,1ére Conférence Internationale sue les Systèmes Electroniques, CISE 05, Batna, Algérie 13-14 Décembre 2005.
- 2-**M. Bouhouche**, S. Latreche, C. Gontrand,"Investigation of process induced defects in SiGe/Si heterojunction bipolar transistors" International conference of modelling and simulation, MS'07, Algiers, Algeria, 2-4 July 2007.
- 3-**M. Bouhouche**, S. Latreche, M. Lakhdara, C.Gontrand, “Effect of Carbon Dose on the Electrical Characteristics of SiGe:C HBTs”,First International Conference on Thin Films and Porous Materials ICTFPM'08, Alger Algérie, 19-22 Mai 2008.

4-M.Lakhdara, S. Latreche, J.C.Nunez- Perez, **M. Bouhouche**, J.Verdier C. Gontrand “ Carbon Effect on the Electrical Characteristics of Hight Speed SiGeC HBT”, E-MRS 2008 Spring Meeting Strasbourg, France Mai 26-30-2008.

5- S. Latreche, M.Lakhdara, **M. Bouhouche**, C. Gontrand, “ Cryogenic Temperature Effect on Electrical Characteristics of SiGe, SiGeC HBT”, Condensed Matter Physics Conference CMPC BC2008, Mugla – Turkey 26-28 Mai 2008.

6-**M. Bouhouche**, S.Latreche and C.Gontrand“**Effect of Implantation Defects and Carbon Incorporation on Si/SiGe Bipolar Characteristics**”, the Second International Conference on Computer and Electrical Engineering, Dubai 2009 (ICCEE 2009).

7-**M. Bouhouche**, S.Latreche, “Time-varying model noise of the of LC oscillator based on SiGe heterojunction transistor”, Third International Conference on Technological Advances in Electrical Engineering (ICTAEE'18.), SkikdaAlgérie 10-12 December 2018.